



# MANUEL TECHNIQUE "RT"

TUBES ÉLECTRONIQUES ET SEMICONDUCTEURS

ÉDITÉ PAR LE BUREAU DE DOCUMENTATION TECHNIQUE DE  
LA RADIODÉFINITION  
130, AVENUE LEDRU-ROLLIN  
PARIS-XII<sup>e</sup>



## Bulletin 62 C

Vous trouverez, ci-joints, plusieurs feuillets destinés à compléter le MANUEL TECHNIQUE "RT" actuellement en votre possession.

Les tableaux ci-annexés vous indiqueront l'ordre dans lequel ces feuillets doivent être classés.

Nous attirons particulièrement votre attention sur les types suivants :

E 288 CC - Double triode à forte pente (18 mA/V) destinée aux amplificateurs de puissance à très large bande et aux amplificateurs de puissance en impulsions rapides, recommandée en particulier pour les distributions collectives de signaux de télévision.

7586 - Triode nuvistor à coefficient d'amplification moyen. ( $K = 35$ ). Ce tube SQ, de faible encombrement, bénéficie de la fiabilité particulière due à la technologie nuvistor. Il peut être utilisé dans toutes les applications RF et AF nécessitant un service intensif dans des conditions difficiles. La pente de ce tube est de 10 mA/V pour une tension anodique de 40 V.

7587 - Tétrode nuvistor à forte pente (10,6 mA/V). L'anode est sortie au sommet de l'enveloppe, ce qui autorise une dissipation de 2,2 W, malgré le faible encombrement du tube. Recommandé pour applications à haute fiabilité.

7895 - Triode nuvistor à grand coefficient d'amplification ( $K = 64$ ). Brochage interchangeable avec 7586. Tube recommandé pour application RF en oscillateur ou amplificateur jusqu'à 300 MHz. Permet d'obtenir un facteur de bruit de l'ordre de 4 à 5 dB à 200 MHz.

- BLINDAGES métalliques à haute perméabilité pour tubes à rayons cathodiques pour mesures.

150AV - 150CV - 150UV - Cellules photoélectriques pour photométrie. Ces cellules comprennent : une photocathode frontale semi-transparente, déposée sur la face interne d'une fenêtre plane optique et une anode métallique de forme cylindrique. Pour assurer un excellent isolement, ces cellules possèdent une sortie latérale pour la photocathode, tandis que l'anode est sortie sur l'embase.

Elles conviennent particulièrement pour les mesures photométriques de grande précision et pour l'équipement des appareils de photométrie qui doivent avoir de bonnes performances.

Ces trois types de cellules se différencient par leur réponse spectrale dont le maximum se situe :

- dans le bleu (4800 Å) pour la 150AV
- dans le bleu/ultraviolet pour la 150UV (quartz)
- dans le rouge (8000 Å) pour le 150CV.

Les avantages de ces cellules sont :

- 1°/ La présence d'une photocathode frontale avec fenêtre à poli-optique permet :
  - a/ - de placer la source lumineuse très près de la photocathode.
  - b/ - de définir avec précision la distance entre la source lumineuse et la photocathode.
- 2°/ Qualité de la photocathode qui possède une bonne uniformité lorsqu'on l'explore suivant un diamètre quelconque.
- 3°/ Linéarité remarquable de la réponse de la cellule en fonction du flux incident.
- 4°/ Absence des phénomènes de charge d'espace.
- 5°/ Très grande stabilité de la cellule.
- 6°/ La sensibilité de la cellule est très peu influencée par une variation de l'angle d'incidence de la lumière reçue sur la photocathode.
- 7°/ Possibilité de refroidissement de la photocathode sans risque de détérioration de la cellule.
- 8°/ Les problèmes d'isolement ne sont pas critiques (faible tension d'alimentation).

**ASZ 21** : Transistor au germanium par alliage - diffusion du type PNP, en boîtier métallique TO-18, destiné aux circuits logiques à transistors à vitesse élevée.

Sa fréquence de coupure minimale est de 300 MHz, et permet des temps de commutation totaux inférieurs à 180 nanosecondes.

Les transistors de ce type sont soumis aux essais climatiques et mécaniques en conformité avec la spécification MIL. 19500

**AF 102** : Transistor au germanium par alliage - diffusion du type PNP en boîtier métallique TO-47, destiné aux applications d'amplification VHF.

Il se signale par un faible bruit et un gain élevé en VHF.

Les propriétés de ce transistor offrent la possibilité d'études de circuits amplificateurs, oscillateurs et convertisseurs jusqu'à 260 MHz.

**BY 100** : Diode de puissance au silicium à jonction diffusée, destinée plus spécialement à l'étage redresseur des récepteurs de télévision.

**AAZ 12** : Diode au germanium. Construction tout verre. Destinée à des applications à courants élevés et à faible temps de recouvrement.

**BYY 22/23** : Redresseur de puissance au silicium par jonction double - diffusée, permettant de soutenir un courant moyen de 10 A sous une tension inverse au récurrent de 200 V. L'anode est constituée par une tresse flexible.

Principales applications : charge de batteries, circuits redresseurs pour fournir un courant continu dans les calculateurs, équipements demandant de la puissance en régime continu.

Le type *BYY 23* est identique électriquement au type *BYY 22* ; mécaniquement les connexions sont inverses.

*BYY 24/25* : Redresseur de puissance au silicium par jonction double - diffusée permettant de soutenir un courant moyen de 10 A sous une tension inverse récurrente de 400 V. L'anode est constituée par une tresse flexible. Applications identiques à celles de la série *BYY 22/23*.

**CHANGEMENT D'ADRESSE** - Dans le cas où vous auriez changé d'adresse et afin de nous permettre de vous assurer à l'avenir le service régulier des feuillets complémentaires, veuillez nous indiquer votre nouvelle adresse sans oublier de nous rappeler l'ancienne à laquelle étaient jusqu'ici envoyés les feuillets.

OCTOBRE 1962